## GaAs 限幅器芯片 DC-3GHz

### 主要性能

◎ 工作频段: DC~3GHz◎ 插入损耗: 0.25dB

◎ 参考耐受功率: 120W (PW 4us 50%)@1GHz

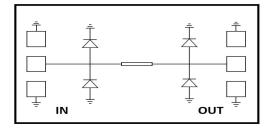
140W (PW 1us 0.1%)@450MHz 130W (PW 4ms 50%)@2GHz

◎ 最大输入功率: 87.5W (CW)@350MHz

73W (CW)@3GHz

◎ 芯片尺寸: 1.78 x 0.987 x 0.1mm

#### 功能框图



## 产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。 该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接 工艺。可应用于以下范围:

◎ 无线通信设备

◎ 军事和航天

◎ 测试仪器

◎ 雷达和电子对抗

#### 极限参数

指标	数值	备注
最大输入功率	87.5W@350MHz	CW, +25°C
	73W@3GHz	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

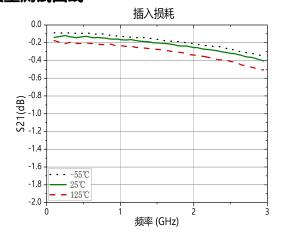
注: 超过最大值都有可能造成永久性损坏

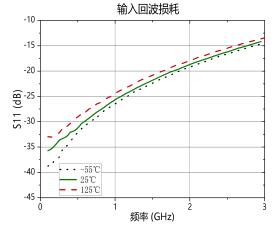
### 电性能表 (TA=+25℃)

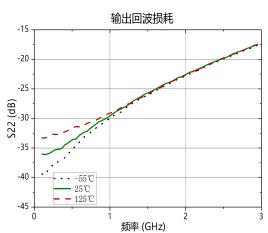
指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.25	-	dB
回波损耗	-	20	36	dB
限幅电平	-	16.5(1GHz)	-	dBm
	-	16(1.5GHz)	-	dBm
	-	15.8(2GHz)	-	dBm
	-	15.5(3GHz)	-	dBm
参考耐受功率	-	120W (PW 4us 50%)@1GHz	-	W
	-	140W (PW 1us 0.1%)@450MHz	-	W
	-	130W (PW 4us 50%)@2GHz	-	W
最大输入功率	-	87.5W(CW)@350MHz	-	W
	-	73W(CW)@3GHz	-	W

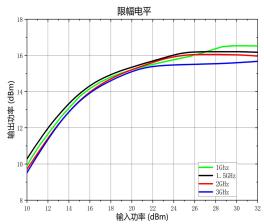
1

## 典型测试曲线

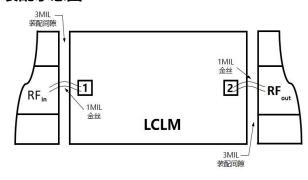




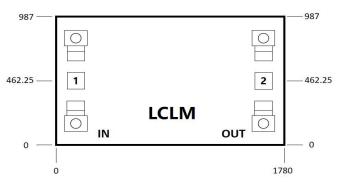




## 装配示意图



## 芯片尺寸图



### 说明:

- 1. 单位: 微米(um), 尺寸公差: ±50um
- 2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100um x 100um
- 3. 芯片背面镀金
- 4. 芯片背面接地
- 5. 不可在通孔上进行键合
- 6. 压点间隙: 150um (GSG)

## 键合压点定义

压点	功能	功能描述	
编号	符号	が能御还	
1 RFin	RF 输入端,阻抗 50 Ω		
	Kriii	(建议外接隔直电容)	
2 RFo	DEout	RF 输出端,阻抗 50Ω	
	Krout	(建议外接隔直电容)	
-	GND	芯片背面必须接地	

2 Tel: 15063901343

# LCLM0003D1

修改内容	修订时间
新增参考耐受功率补测频点	2024.07.10
补测2GHz频点参考耐受功率	2024.07.30
更新了脉冲波1GHz频点的参考耐受功率	2024.07.31

3 Tel: 15063901343